# 電子衝突によるヘリウム自動電離スペクトレ の衝突エネルギー、放出角依存性

#### 原子物理研究室 若林潤

# <本研究の目的>

Heの二電子励起状態からの放出電子 スペクトレの衝突エネルギー、角度依 存性を系統的に調べ、二電子励起状態 の生成、崩壊の過程を明らかにする。

#### <過去の本研究室における研究成果>

1.高エネルギー電子衝突によるHeの 2121'系列からの放出電子スペクトル の形状因子の決定した

2.一次のボルン近似による計算結果 との比較をした結果、1keVにおいて も大きく異なるということがわかった



200eV以下の低エネルギー電子衝突

1.2121'状態からの放出電子スペクHレの 形状因子の決定

2.2l3l'状態及び(2p<sup>2</sup>)<sup>1</sup>Sからの放出電子スペ クHレの測定

3. 二電子励起閾値付近でのPCI効果の観測



平均軌道半径50mm



#### < 放出電子スペク Hレ >



#### < 放出電子スペク Hレ >



#### 1.2121'状態からの放出電子スペクHレの 形状因子の決定

#### 2.2131<sup>'</sup>状態及び(2p<sup>2</sup>)<sup>1</sup>Sからの放出電子スペ クトレの測定

3. 二電子励起閾値付近でのPCI効果の観測



#### a,bがピークの形状を特徴付ける形状因子



$$a = \frac{8k_{s}}{k_{0}} \int \frac{d\Omega_{s}}{k^{4}} \left\{ \operatorname{Re}\left[\sum_{m=0}^{\infty} I_{m} I_{m}(q(K) - i)\right] \right\}$$
$$b = \frac{8k_{s}}{k_{0}} \int \frac{d\Omega_{s}}{k^{4}} \left\{ \operatorname{Im}\left[\sum_{m=0}^{\infty} I_{m}^{l} I_{m}(q(K) - i)\right] + \frac{1}{2} \left|q(K)^{2} + 1\right| \right\}$$

共鳴に関与する部分波と他の部分波の干渉がa,bに反映される

散乱電子に対するFanoのqパラメータ  

$$q(K) = (\pi v_{\mu})^{-1} \frac{J_{\mu}(\vec{k}_{0},\vec{k}_{s})}{I_{\mu}(\vec{k}_{0},\vec{k}_{s},\vec{k}_{e})} p_{\nu_{m}^{2}} = \frac{1}{2}\Gamma_{m}$$
  
 $k_{s}$ :散乱電子運動量  $J_{\mu}$ :二電子励起への散乱振幅  
 $k_{0}$ :衝突電子の運動量  $I_{\mu}$ :J<sub>µ</sub>と同じ角運動量を持つ電離の散乱振幅  
 $d\Omega_{s}$ :散乱電子の立体角  $I_{\mu'}$ :J<sub>µ</sub>と別の角運動量を持つ電離の散乱振幅

< スペク Hレの フィッティング >

衝突エネルギー200eV測定角度35°~130°の測定結果に おいてshoreの式でフィッティングを行った。

<分析器の分解能を考慮したShoreの式>

$$Y_{fit}(E_i) = \frac{1}{\sqrt{p}\Delta E} \int_{-\infty}^{+\infty} F(E) \exp\left\{-\left(\frac{E-E_i}{\Delta E}\right)^2\right\} dE \qquad \text{(But } \Delta E = \frac{\Delta E_{FWHM}}{2\sqrt{\ln 2}}$$

Single particle notation	$_{N}(K,T)_{n}^{A}$	$^{2s+1}L$	放出電子 エネルギー	自然幅
${}^{1}S^{e}$	$_{2}(1,0)_{2}^{+}$	$(2s^{2})$	33.255eV	0.12 eV <sup>A</sup>
$^{1}D^{e}$	$\frac{1}{2}(1,0)^{\frac{1}{2}}$	$(2p^{2})$	35.322eV	0.072eV <sup>B</sup>
$^{1}P^{o}$	$\left[ \begin{array}{c} -\\ 2 \end{array} (0,1)^{+}_{2} \right]$	(2s2p)	35.56 eV	$0.038 eV^B$

<参考文献 >A:增田 明 修士論文(2004) B:J.P.van den Brink et al J.phys.B22:3501(1989)

< スペク HVの fitting 例 >





200eV,1keVの <sup>1</sup>Pの形状因子 の比較





200eV,1keVの <sup>1</sup>Pの形状因子 の比較

<sup>1</sup>Pではa,bともに 200eVのほうが1keV よりも振動の間隔が 狭くなっていることが わかる



200eV,1keVの <sup>1</sup>Dの形状因子 の比較



200eV,1keVの <sup>1</sup>Dの形状因子 の比較



#### 1.2121'状態からの放出電子スペクHレの 形状因子の決定

- 2.2131<sup>'</sup>状態及び(2p<sup>2</sup>)<sup>1</sup>Sからの放出電子スペ クトレの測定
- 3. 二電子励起閾値付近でのPCI効果の観測

#### < 放出電子スペク Hレ >



< スペク Hレの フィッティング >

衝突エネルギー150eV、測定角度35°~130°の測定結果に おいてshoreの式でフィッティングを行い、形状因子を決定した

	Single particle notation	$_{N}(K,T)_{n}^{A}$	$^{2s+1}L$	放出電子 エネルギー	自然幅	
	${}^{1}S^{e}$	$_{2}(-1,0)_{2}^{+}$	$(2p^{2})$	37.498eV	0.0058 eV	(a)
	${}^{1}S^{e}$	$_{2}(1,0)_{3}^{+}$	(2s3s)	38.37 eV	0.037 eV	(a)
	${}^{1}D^{e}$	$_{2}(1,0)_{3}^{+}$	(2p2p)	38.93 eV	0.0153 eV	(b)
	$^{1}P^{o}$	$_{2}(0,1)_{3}^{+}$	( <i>sp</i> 23+)	39.07 eV	0.00819eV	(c)
(a)E.L	indroth,Phys.F	Rev.A <b>49.</b> 4473(	1994) (b)J.Z	.Tang et al.Phys.	Rev.A 46,2437	7(1992

(c)Y.K.Ho,Phys.Rev.A 23,2137(1981)

## < (2p<sup>2</sup>)<sup>1</sup>Sおよび2131'系列のFitting >

Impact Energy 150eV



 $(2p^2)^1S,(2s^2)^1SO$ <sup>1</sup>Pの形状因子の 比較





<分子模型による2121、系列の分類>



#### 1.2l2l'状態からの放出電子スペクトレの 形状因子の決定

#### 2. 2l3l'状態及び(2p<sup>2</sup>)<sup>1</sup>Sからの放出電子スペ クHレの測定

3. 二電子励起閾値付近でのPCI効果の観測

## < 放出電子スペク Hレ >



Emitted electron yield, arbitrary units

Emitted Electron Energy (eV)



## (post-collision interaction)



遅い散乱電子がHe原子の近くにいるため放出 電子が散乱電子による反発をうけて加速される。

#### 寿命の短いピークのシフト、ブロードニングが観測される

< PCI効果のエネルギー依存性 >



古典論的なPCI効果で は説明できない2電子 励起状態同士の干渉を 観測することができた

#### < PCI効果の角度依存性 >



### < 放出電子スペク Hレ >



### < 放出電子スペク Hレ >



#### <放出電子と散乱電子の共鳴>

#### < 衝突過程 >

 $e_i + He \rightarrow He^{**} + e_s(0) \rightarrow He^+ + e_s(0) + e_j \rightarrow He(1snl) + e_j$ 

 $e_i + He \rightarrow He(1snl) + e_s$ 

二電子励起状態からの放出電子が、一電子励起を起こした散乱電子として観測されている

<まとめ>

#### 1.2121'系列の測定

・形状因子は極大・極小を持つ振動的な振る舞いをすることがわかった。 低いエネルギーの方が極大と極小の間隔が狭くなりa,bで極大・極小の 位置が等間隔にずれている。

- 2.2131'系列および(2p<sup>2</sup>)<sup>1</sup>S
  - ・Qp<sup>2</sup>)<sup>S</sup><sup>e</sup>のbパラメータは(2s<sup>2</sup>)<sup>1</sup>S<sup>e</sup>と著しい違いがみられた。このことは分 子模型による電子配置の違いを反映しているものと考えられる。
- 3.二電子励起閾値付近におけるPCI効果の観測 PCI効果に角度依存性があることがわかった (2s2p)<sup>3</sup>Pのピークも励起閾値付近ではブロードになることがわかった。 励起閾値付近ではPCI効果によって放出電子と散乱電子との共鳴が起 こっていることがわかった。



200eV,1keVの <sup>1</sup>Sの形状因子 の比較



200eV,1keVの <sup>1</sup>Sの形状因子 の比較



 $<_{n}(K,T)_{N}^{A\ 2S+1}L^{p}>$ 

相関量子数  

$$T = 0,1,2,\dots,\min(L, N-1)$$

$$K = N-1-T, N-3-T,\dots,-(N-1-T)$$

$$\begin{cases}
A = p(-1)^{S+T} \quad (K > L-N) \\
A = 0 \quad (K \le L-N)
\end{cases}$$

$${}_{2}(1,0)_{2}^{+1}S^{e} \qquad {}_{2}(-1,0)_{2}^{+1}S^{e} \qquad {}_{2}(-1,0)_{$$

#### $< (2s3s)^{1}SOF$ itting >

Impact Energy 150eV Ejection Angle 130 °



E.Lindroth, Phys.Rev.A **49**, 4473(1994)



E.Lindroth, Phys.Rev.A **49**, 4473(1994)

J.Z. Tang et al, Phys. Rev. A 46, 2437(1992)

<(2p2)<sup>1</sup>Sの角度依存性>

